

Rot-, grün- und gelbleuchtende Lumineszenzdioden (GaAsP und GaP) Red, green and yellow Light Emitting Diodes (GaAsP and GaP)

Anwendung: Allgemeine Anzeigezwecke **Application:** General indicating purposes

Besondere Merkmale:

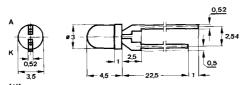
- Kunststoffgehäuse Ø 3 mm
- Großer Betrachtungswinkel
- Axiale Anschlüsse
- Höhere Lebensdauererwartung als Glühlampen
- Erschütterungsunempfindlich
- TTL-kompatibel
- Rotleuchtend CQY 85, V 178 P GaAsP
- Grünleuchtend CQY 86, V 179 P GaP
- Gelbleuchtend CQY 87, V 180 P GaAsP

Features:

- Plastic case Ø 3 mm
- Wide viewing angle
- Axial terminals
- Long life compared with filament lamps
- Vibration resistant
- TTL-compatible
- Red light emitting CQY 85, V 178 P GaAsP
- Green light emitting CQY 86, V 179 P
 GoP
- Yellow light emitting CQY 87, V 180 P GaAsP

Vorläufige technische Daten · Preliminary specifications

Abmessungen in mm Dimensions in mm



Abstrahlwinkel α Angle of half intensity

 $\alpha = 60^{\circ}$

Spezialgehäuse Special case Kunststoff, matt Plastic, dull rot, grün und gello red, green and yellow Gewicht · Weight max. 0,3 g

Zubehör Accessories

Montagehülse Mounting clip

Best.-Nr. 562 247

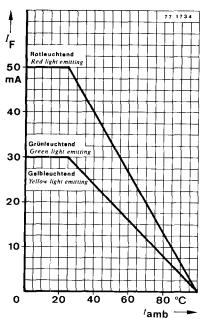
Haltering Retainer ring

Best.-Nr. 562248

CQY 85 · CQY 86 · CQY 87 V 178 P · V 179 P · V 180 P

Absolute Grenzdaten Absolute maximum ratings

Sperrspannung Reverse voltage		U_{R}	5	V
Durchlaßstrom Forward current	CQY 85	I _F	50	mA
Stoßdurchlaßstrom Forward surge current	CQY 86, CQY 87	/ _F	30	mA
[≀] p ≦10 μs		I_{FSM}	1	Α
Verlustleistung Power dissipation				
$t_{amb} \le 25 ^{\circ}\text{C}$		P_{V}	100	mW
Sperrschichttemperatur Junction temperature		$t_{\mathbf{j}}$	100	°C
Lagerungstemperaturbereich Storage temperature range		^t stg	-20 +100	°C
Maximal zulässige Löttempera Soldering temperature, maxima $t \le 3$ s				
Abstand von der Aufsetzkante Distance from the touching bor		^t sd	245	°C



i) mit zwischengelegter Leiterplatte with intermediate PC-board

Wärmewiderstand Thermal resistance		Min.	Тур.	Max.	
Sperrschicht-Umgebung Junction ambient	R_{thJA}			750	°C/W
Optische und elektrische Kenngrößen Optical and electrical characteristics					
$t_{amb} = 25 ^{\circ}\text{C}$					
Lichtstärke Luminous intensity I _F = 20 mA CQY 85 CQY 86	$I_{\mathbf{V}}^{\star})^{1}$) $I_{\mathbf{V}}^{\star})^{1}$	0,8	1,6 2 3		mcd mcd
CQY 87 V 178 P V 179 P V 180 P	$I_{V}^{\star})^{1}$ $I_{V}^{\star})^{1}$ $I_{V}^{\star})^{1}$ $I_{V}^{\star})^{1}$	1 2 2 2	4 5		mcd mcd mcd mcd
Wellenlänge der maximalen Emission Peak wavelength emission					
CQY 85, V 178 P CQY 86, V 179 P CQY 87, V 180 P	^λ p ^λ p ^λ p		660 560 590		nm nm nm
Spektrale Halbwertsbreite Spectral half bandwidth	r				
CQY 85, V 178 P CQY 86, CQY 87, V 179 P, V 180 P	Δλ Δλ		20 40		nm nm
Durchlaßspannung Forward voltage I _F = 20 mA	<i>U</i> F*) <i>U</i> F*)		1,6 2,7	2,0 3,2	v v
Durchbruchspannung Breakdown voltage $I_{ m R}$ = 100 $\mu{ m A}$	<i>U</i> (BR) *)	5			٧
Sperrschichtkapazität Junction capacitance $U=0$, $f=1$ MHz	C _j		50		pF

^{*)} AQL = 0,65%

¹⁾ in Gruppen sortiert lieferbar, Lichtstärkeunterschiede in einer Verpackungseinheit m = 0,5 ... 1 in groups selected available, luminous intensity in packing unit m = 0.5 ... 1

